



汕头华汕电子器件有限公司

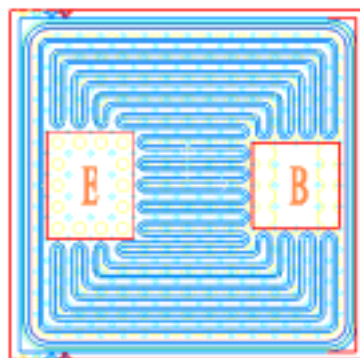
NPN SILICON TRANSISTOR

3420 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C126AG-00
芯片厚度： $240 \pm 20\mu\text{m}$
管芯尺寸： $1260 \times 1260\mu\text{m}^2$
焊位尺寸：B 极 $308 \times 308\mu\text{m}^2$ ；E 极 $308 \times 385\mu\text{m}^2$
电极金属：铝
背面金属：银
典型封装：2SC3420，H3420

管芯示意图



极限值 ($T_a=25$) (封装形式：TO-126)

T_{stg}	贮存温度	-55~150
T_j	结温	150
P_C	集电极功率耗散 ($T_c=25$)	10W
P_C	集电极功率耗散 ($T_a=25$)	1.5W
V_{CBO}	集电极—基极电压	40V
V_{CEO}	集电极—发射极电压	20V
V_{EBO}	发射极—基极电压	8V
I_C	集电极电流 (DC)	5A
I_C	集电极电流 (脉冲)	8A
I_B	基极电流	1A

电参数 ($T_a=25$) (封装形式：TO-126)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	集电极—发射极击穿电压	20			V	$I_C=10\text{mA}$ ， $I_B=0$
I_{CBO}	集电极—发射极截止电流			100	nA	$V_{\text{CE}}=40\text{V}$ ， $I_B=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			100	nA	$V_{\text{EB}}=8\text{V}$ ， $I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	140		600		$V_{\text{CE}}=2\text{V}$ ， $I_C=500\text{mA}$
		70				$V_{\text{CE}}=2\text{V}$ ， $I_C=4\text{A}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压			1.0	V	$I_C=4\text{A}$ ， $I_B=100\text{mA}$
$V_{\text{BE(on)}}$	基极—发射极导通电压			1.5	V	$V_{\text{CE}}=2\text{V}$ ， $I_C=4\text{A}$
f_T	特征频率		100		MHz	$V_{\text{CE}}=2\text{V}$ ， $I_E=500\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		40		pF	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$ ， $I_E=0$ ， $f=1\text{MHz}$

Pulse Test: $PW=10\text{mS}(\text{max})$, Duty Cycle=30%(min)